

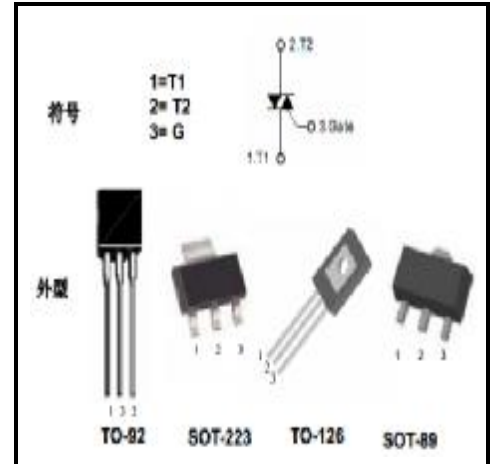
## BT131(TO-92)双向可控硅

### n 特点:

先进的台面玻璃钝化工艺，具有通态压降低，门极逻辑电平触发等特点，可直接应用 IC 驱动。

### n 用途:

广泛应用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动、摩托车点火器等小功率电流相控电路。



### n 极限参数:

名称	符号	数值	单位	条件
重复峰值阻断电压	$V_{DRM}$	$\geq 600$	V	$I_{DRM}=20\mu A$
通态均方根电流	$I_{T(RMS)}$	1	A	所有导通角
通态浪涌电流	$I_{TSM}$	10	A	$t=10ms$
门极峰值电流	$I_{GM}$	1.2	A	$T_j=125^\circ C$
结温范围	$T_j$	$-40\sim 125$	$^\circ C$	---
贮存温度	$T_{stg}$	$-40\sim 150$	$^\circ C$	---

### n 电特性 ( $T_j=25^\circ C$ ):

名称	符号	测试条件	Min	Max	Type	单位
正向断态峰值电流	$I_{RRM}$	$T_j=125^\circ C$ $V_{RRM}=V_{DRM}$	----	0.1	----	mA
通态峰值电压	$V_{TM}$	$I_{TM}=6A$ $t=380\mu s$	----	----	1.5	V
门极触发电流	I - II - III	$V_D=12V$ $R_L=30\Omega$	----	5	----	mA
	IV		----	30	----	mA
门极触发电压	I - II - III	$V_D=12V$ $R_L=30\Omega$	----	2	----	V
	IV		----	2.5	----	V
门极不触发电压	$V_{GD}$	$V_D=V_{DRM}$ $T_j=125^\circ C$	0.2	----	----	V
断态电压临界上升率	dV/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=125^\circ C$	10	----	----	V/ $\mu s$
通态电流临界上升率	dI/dt	$I_T=6A$ $I_g=0.2A$ $dI_g/dt=0.2A/\mu s$	50		----	A/ $\mu s$
维持电流	$I_H$	$I_T=0.2A$	$\leq 25$		----	mA